## Сверхпроводимость в системе $Ba_{1-x}La_xPbO_3$

© А.П. Менушенков, А.В. Цвященко<sup>\*</sup>, Д.В. Еременко, К.В. Клементьев, А.В. Кузнецов, В.Н. Трофимов<sup>\*\*</sup>, Л.Н. Фомичева<sup>\*</sup>

Московский государственный инженерно-физический институт,

115409 Москва, Россия

\*Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук,

142092 Троицк, Московская обл., Россия

\*\*Объединенный институт ядерных исследований,

141980 Дубна, Московская обл., Россия

E-mail: menushen@htsc.mephi.ru

(Поступила в Редакцию 12 июля 2000 г. В окончательной редакции 2 октября 2000 г.)

> В рамках эмпирической модели взаимосвязи локальной кристаллической и электронной структуры перовскитных систем  $Ba_{1-x}K_xBiO_3$  и  $BaPb_{1-x}Bi_xO_3$ , построенной на основе результатов EXAFS спектроскопии указанных соединений, сделан вывод о возможности сверхпроводимости в системе  $Ba_{1-x}La_xPbO_3$ . Обнаружено, что в многофазном соединении  $Ba_{1-x}La_xPbO_3$ , синтезированном при давлении 6.7 GPa, присутствует сверхпроводящая фаза с критической температурой  $T_c \simeq 11$  K.

> Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 99-02-17343 и 99-02-17897) и программой Миннауки РФ "Фундаментальные аспекты физики конденсированного состояния" (грант № 99010).

Соединение BaBiO<sub>3</sub> относится к классу кубических перовскитов с общей формулой АВО3, основу которых составляют октаэдрические комплексы ВО<sub>6</sub>. BaBiO<sub>3</sub> является диэлектриком, а при замещении части ионов висмута в позиции В на свинец или ионов бария в позиции А на калий или рубидий образуются твердые растворы замещения Ba<sub>1-x</sub>K<sub>x</sub>BiO<sub>3</sub> (BKBO) и BaPb<sub>1-x</sub>Bi<sub>x</sub>O<sub>3</sub> (ВРВО), в которых с ростом концентрации допирующей примеси наблюдается фазовый переход металлдиэлектрик. После фазового перехода указанные соединения становятся металлическими сверхпроводниками с  $T_c \simeq 13$  К в ВаРb<sub>0.75</sub>Вi<sub>0.25</sub>O<sub>3</sub> [1] и  $T_c \simeq 30$  К в Ва<sub>0.6</sub>К<sub>0.4</sub>ВіО<sub>3</sub> [2]. Для выявления механизмов влияния допирования по А- и В-позициям на свойства висмутатов в нормальном и сверхпроводящем состояниях были предприняты попытки синтеза новых сверхпроводников на основе ВаВіО<sub>3</sub>, имевшие целью поиск соединений с более высокими критическими температурами [3]. При этом было обнаружено, что химические модификации, не образующиеся в нормальных условиях, успешно синтезируются при высоких давлениях. В результате была синтезирована новая сверхпроводящая фаза: (K<sub>1-x</sub>Bi<sub>x</sub>)BiO<sub>3</sub> с  $T_c \simeq 10.2 \,\mathrm{K}$  при  $x = 0.1 \,[3]$ .

В отличие от слоистых высокотемпературных сверхпроводников твердые растворы на основе BaBiO<sub>3</sub> имеют слабоискаженную кубическую структуру. Они характеризуются изотропией физических свойств и отсутствием магнитных взаимодействий. Более простая структура 6s-2p валентной зоны висмутатов по сравнению с 3d-2p зоной высокотемпературных сверхпроводников и отсутствие резервуаров заряда вне BO<sub>6</sub> октаэдрических комплексов существенно облегчают анализ электронной структуры висмутатов. На основе такого анализа была предложена эмпирическая модель, увязывающая особенности локальной кристаллической и локальной электронной структуры висмутатов и объясняющая причину появления фазового перехода диэлектрик-металл и возникновения сверхпроводимости [4–6]. Далее в рамках данной модели сделан вывод о возможности возникновения сверхпроводимости в соединении  $Ba_{1-x}La_xPbO_3$ , не содержащем ионов висмута.

Исходное для перечисленных выше систем соединение ВаВіО<sub>3</sub> имеет моноклинно искаженную кубическую решетку. Данное искажение является комбинацией статического поворота BiO<sub>6</sub> октаэдров вокруг осей типа [110] — вращательное искажение — и чередования октаэдров большего и меньшего размеров — искажение "дыхательной" моды. Изначально неэквивалентность октаэдров связывалась с диспропорционированием валентности висмута  $2\mathrm{Bi}^{4+} 
ightarrow \mathrm{Bi}^{3+} + \mathrm{Bi}^{5+}$ , вызывающим волну зарядовой плотности, приводящую к удвоению объема элементарной ячейки и появлению диэлектрической щели [7]. Допирование калием или свинцом уменьшает оба типа искажений и разрушает волну зарядовой плотности. Например, металлическая сверхпроводящая фаза  $Ba_{1-x}K_xBiO_3$  при x > 0.37 имеет неискаженную кубическую структуру [8]. На основании данных рентгеноструктурного анализа и упругого рассеяния нейтронов [8,9] принято считать, что неэквивалентность валентных состояний висмута, характерная для BaBiO<sub>3</sub>, исчезает при допировании, и в сверхпроводящей фазе ВКВО или ВРВО все ионы висмута находятся в одном состоянии. В результате утверждалось, что неэквивалентность состояний висмута обусловливает диэлектрические свойства ВаВіО<sub>3</sub> и не связана со сверхпроводимостью [10].

Отметим, что упомянутые выше методы дают картину структуры, усредненную по объему образца. Исследования структуры систем ВКВО-ВРВО локально чувствительным методом EXAFS и прецизионные измерения фотоэмиссионных спектров обнаружили, что неэквивалентность состояний висмута сохраняется и в сверхпроводящих составах ВКВО. Это экспериментально проявляется в виде сильно ангармонических колебаний ионов кислорода в двухъямном потенциале вдоль связей Bi–O–Bi [5,11] и расщеплении Bi 4f линий фотоэмиссионных спектров [12]. Поэтому на основе экспериментальных данных EXAFS была предложена новая модель электронной структуры и транспортных свойств висмутатов [4–6].

Было показано, что кристаллическая структура ВаВіО<sub>3</sub> описывается упорядоченным чередованием октаэдрических комплексов  $BiO_6$  и  $BiL^2O_6$ , где  $L^2$ означает присутствие пары дырок в гибридизированной антисвязывающей 6sBiO2p<sub>σ\*</sub> орбитали комплекса. характеризуется Электронная структура BaBiO<sub>3</sub> системой локальных электронных и дырочных пар, разделенных энергетически диэлектрической щелью  $2E_a = 0.48 \,\mathrm{eV}$ . Пары разделены и пространственно, так как принадлежат различающимся комплексам: электронные — BiO<sub>6</sub>, а дырочные — BiL<sup>2</sup>O<sub>6</sub>. Свободных носителей заряда в системе нет, и проводимость обусловлена двухчастичным переносом заряда при динамическом обмене  $BiL^2O_6 \leftrightarrow BiO_6$ .

Замещение части ионов  $Ba^{2+}$  ионами K<sup>+</sup> уменьшает число электронов и переводит часть комплексов  $BiO_6$  в состояние  $BiL^2O_6$ . С ростом числа  $BiL^2O_6$  комплексов при их пространственном перекрытии создается непрерывный  $BiL^2O_6$  кластер, в котором из свободных  $L^2$  уровней образуется зона проводимости, поэтому происходит фазовый переход диэлектрик-металл. При этом диэлектрическая щель исчезает и локальные электронные пары с комплексов  $BiO_6$  свободно перемещаются через  $BiL^2O_6$ кластеры, обусловливая переход в сверхпроводящее состояние при  $T < T_c$ .

Полное замещение ионов Ва на ионы К соответствует соединению KBiO<sub>3</sub>, состоящему только из комплексов BiL<sup>2</sup>O<sub>6</sub>, которое должно быть несверхпроводящим металлом, так как в нем отсутствуют комплексы BiO<sub>6</sub>, содержащие электронные пары. Для появления сверхпроводимости необходимо создать пары, преобразовав часть комплексов BiL<sup>2</sup>O<sub>6</sub> в BiO<sub>6</sub>. Это было недавно достигнуто при легировании KBiO<sub>3</sub> в позиции А трехвалентными ионами Bi<sup>3+</sup> [3].

Соединение BaPbO<sub>3</sub> является электронным аналогом KBiO<sub>3</sub>. Оно состоит из эквивалентных комплексов PbL<sup>2</sup>O<sub>6</sub> [4–6] и имеет металлические свойства. Сверхпроводимость отсутствует в BaPbO<sub>3</sub>, но появляется при легировании висмутом в BaPb<sub>1-x</sub>Bi<sub>x</sub>O<sub>3</sub> и наблюдается в достаточно узком диапазоне допирования 0.05 < x < 0.35 [1]. Появление сверхпроводимости связано с появлением локальных электронных пар на BiO<sub>6</sub> комплексах. Электронная структура октаэдров PbL<sup>2</sup>O<sub>6</sub> с ионами свинца в центре идентична структуре BiL<sup>2</sup>O<sub>6</sub> комплексов. Поэтому металлические свойства BaPb<sub>1-x</sub>Bi<sub>x</sub>O<sub>3</sub> обусловлены наличием зоны проводимости из свободных L<sup>2</sup> уровней в непрерывном кластере,

состоящем как из PbL<sup>2</sup>O<sub>6</sub>, так и из комплексов BiL<sup>2</sup>O<sub>6</sub>, а сверхпроводимость объясняется когерентным переносом пар при динамическом обмене BiL<sup>2</sup>O<sub>6</sub>  $\leftrightarrow$  BiO<sub>6</sub> и PbL<sup>2</sup>O<sub>6</sub>  $\leftrightarrow$  BiO<sub>6</sub>.

Из приведенного выше следует, что сверхпроводимость в BaPbO<sub>3</sub> можно получить путем замены части октаэдров PbL<sup>2</sup>O<sub>6</sub> на PbO<sub>6</sub> за счет электронного легирования при замещении части ионов Ba<sup>2+</sup> трехвалентными ионами, так как такое легирование должно приводить к формированию локальных электронных пар в комплексах PbO<sub>6</sub>. Мы попытались проверить данное предположение экспериментально.

Среди трехвалентных ионов  $La^{3+}$  имеет ионный радиус 1.17 Å, наиболее близкий к 1.49 Å для  $Ba^{2+}$ . Столь большая разность ионных радиусов препятствует образованию соединения  $Ba_{1-x}La_xPbO_3$  при нормальном давлении. Наши неоднократные попытки получить соединение методом твердофазного синтеза в атмосфере кислорода или на воздухе закончились неудачно, что обусловило необходимость проведения синтеза под высоким давлением.

Образцы номинального состава  $Ba_{0.9}La_{0.1}PbO_3$  синтезировались из оксидов  $BaO_2$ ,  $La_2O_3$ , PbO и PbO<sub>2</sub> чистотой 99.9%. В аргоновой атмосфере стехиометрическая смесь хорошо перемещенных оксидов прессовалась и закладывалась в цилиндрическую платиновую ампулу объемом 90 mm<sup>3</sup>, которая затем монтировалась в тороидальную камеру высокого давления [13]. При давлении 6.7 GPa ампула за 12 min разогревалась до 1000°C, выдерживалась при данной температуре в течение 20 min и за несколько секунд охлаждалась до комнатной температуры. Синтезированная керамика имела черный цвет, а на свежем изломе наблюдался металлический блеск. Проведенный рентгеноструктурный анализ показал, что синтезировано многофазное соединение. Одна из фаз



**Рис. 1.** Температурная зависимость намагниченности. На вставке в увеличенном масштабе приведена зависимость вблизи критической температуры. Стрелкой помечена критическая температура свинца.



**Рис. 2.** Полевая зависимость намагниченности при гелиевой температуре. На вставках в увеличенном масштабе приведена зависимость в слабых и сильных полях. Стрелкой помечено критическое поле свинца.

соответствует перовскитной структуре с параметрами решетки, близкими к BaPbO<sub>3</sub>. Идентификация остальных фаз не проводилась.

Намагниченность синтезированного соединения измерялась на магнитометре СКВИД [14]. Приведенная на рис. 1 температурная зависимость намагниченности свидетельствует о наличии в образце двух сверхпроводящих фаз. Фаза с бо́лышим объемом, который при T = 4.2 К не превышает 28%, имеет критическую температуру  $T_c \simeq 7.2$  К, однако в малой доли образца,  $\sim 1\%$ , сверхпроводимость сохраняется вплоть до  $T_c \simeq 11$  К.

Существование двух сверхпроводящих фаз с различающимися параметрами подтверждает и представленная на рис. 2 полевая зависимость намагниченности, измеренная при T = 4.2 К. В слабых полях  $H \leq 520$  Ое наблюдается значительный полевой гистерезис, связанный с пиннингом потока в образце. В больших полях как сама намагниченность, так и ее гистерезис малы. При  $H \gtrsim 5000$  Ое сверхпроводимость подавляется, намагниченность становится обратимой и линейно растет с полем. Наклон обратимой кривой намагничивания соответствует парамагнитной восприимчивости  $\chi = 1.14 \cdot 10^{-3}$  cm<sup>3</sup>/mol.

Наличие в образце сверхпроводящей фазы с критической температурой, близкой к  $T_c$  металлического свинца, может быть связано с возможным восстановлением части свинца в химической реакции под высоким давлением. В пользу такого предположения говорит также тот факт, что гистерезис кривой намагничивания возникает в полях меньших критического поля свинца.

Очень малую величину объема сверхпроводящей фазы с  $T_c \simeq 11$  К можно объяснить тем, что она, по-видимому, возникает лишь на границах зерен синтезируемой керамики, где вследствие напряженного состояния решетки

создаются более благоприятные условия для стабилизации фаз с большой разницей радиусов ионов, формирующих решетку. Можно надеяться, что оптимизация давления и температуры синтеза, режима охлаждения и состава шихты позволят увеличить объем сверхпроводящей фазы  $Ba_{1-x}La_xPbO_3$  до величины, достаточной для идентификации ее стехиометрии и кристаллической структуры. В заключение необходимо подчеркнуть, что в системе  $Ba_La-O$  и  $Ba_Pb-O$  сверхпроводимость ранее не наблюдалась.

## Список литературы

- A.W. Sleight, J.L. Gillson, P.E. Bierstedt. Solid State Commun. 17, 27 (1975).
- [2] R.J. Cava, B. Batlogg, J.J. Krajewski, R. Farrow, L.W. Rupp, jr., A.E. White, K. Short, W.F. Peck, T. Kometani. Nature 332, 814 (1988).
- [3] N.R. Khasanova, A. Yamamoto, S. Tajima, X.-J. Wu. Physica C305, 275 (1998).
- [4] А.П. Менушенков. Поверхность 3, 14 (1999); 12, 58 (1999).
- [5] A.P. Menushenkov, K.V. Klementev. J. Phys.: Condens. Matter. 12, 3767 (2000).
- [6] M.Yu. Kagan, A.P. Menushenkov, K.V. Klementev, A.V. Kuznetsov (to be published).
- [7] D.E. Cox, A.W. Sleight. Acta Crystallogr. B35, 1 (1989).
- [8] S. Pei, J.D. Jorgensen, B. Dabrowski, D.G. Hinks, D.R. Richards, A.W. Mitchell, J.M. Newsam, S.K. Sinha, D. Vaknin, A.J. Jacobson. Phys. Rev. B41, 4126 (1990).
- [9] J.P. Wignacourt, J.S. Swinnea, H. Steinfink, J.B. Goodenough. Appl. Phys. Lett. 53, 1753 (1988).
- [10] M. Shirai, N. Suzuki, K. Motizuki. J. Phys.: Condens. Matter. 2, 3553 (1990).
- [11] А.П. Менушенков, К.В. Клементьев, П.В. Конарев, А.А. Мешков. Письма в ЖЭТФ 67, 977 (1998).
- [12] M. Qvarford, V.G. Nazin, A.A. Zakharov, M.N. Mikheeva, J.N. Anderson, M.K.-J. Johansson, T. Rogelet, S. Söderholm, O. Tjernberg, H. Nylén, I. Lindau, R. Nyholm, U.O. Karlsson, S.N. Barilo, S.V. Shiryaev. Phys. Rev. B54, 6700 (1996).
- [13] L.G. Khvostantsev, L.F. Vereshchagin, A.P. Novikov. High Temp. High Press. 9, 637 (1977).
- [14] V.N. Trofimov. Cryogenics **32**, 513 (1992).